








ПОВЕРХНОСТЬ. РЕНТГЕНОВСКИЕ, СИНХРОТРОННЫЕ И НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российская академия наук
Институт физики твердого тела РАН
(Москва)

Номер: 9 Год: 2025

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | ПРОСТАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА С АЛМАЗНЫМ КРИСТАЛЛОМ-МОНОХРОМАТОРОМ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ СПЕКТРОМИКРОСКОПИИ | 3-11 |
| | <i>Хомяков Ю. В., Горбачев М. В., Чернов В. А., Дарьин Ф. А., Ракшун Я. В.</i> | |
|  | НЕРАЗРУШАЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СПЕКТРОСКОПИИ ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ | 12-19 |
| | <i>Афанасьев В. П., Лобанова Л. Г., Завгородняя А. М., Семенов-Шефов М. А.</i> | |
|  | ФОРМИРОВАНИЕ И РЕЛАКСАЦИЯ УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ В РАДИАЛЬНЫХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ INASiNP | 20-29 |
| | <i>Федина С. В., Федоров В. В., Кавеев А. К., Голтаев А. С., Минин Д. В., Кириленко Д. А., Мухин И. С.</i> | |
|  | ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В ОПТИЧЕСКИХ НАНОРЕЗОНАТОРАХ GaP | 30-36 |
| | <i>Фунтикова А. С., Можаров А. М., Федоров В. В., Мухин И. С.</i> | |
|  | ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЕВ НАНОПОРИСТОГО ГЕРМАНИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ ИНДИЯ | 37-45 |
| | <i>Степанов А. Л., Валеев В. Ф., Нуждин В. И., Rogov A. M., Коновалов Д. А.</i> | |
|  | ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЫЩЕНИЯ ДЕЙТЕРИЕМ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ АЛМАЗНОЙ МИШЕНИ НА ИОННОМ УСКОРИТЕЛЕ ГЕЛИС | 46-52 |
| | <i>Курсанов М. А., Климанов С. Г., Негодаев М. А., Мовчун С. А.</i> | |
|  | ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА НА МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИХ ОДНОРОДНОСТЬ АМОРФНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА | 53-66 |
| | <i>Некрасов Е. С., Бойко А. Н., Кузнецов Н. В., Скулкина Н. А.</i> | |
|  | КИНЕТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНАМИ ПОРОШКА CaSiO_3, МОДИФИЦИРОВАННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ SeO_2 | 67-72 |
| | <i>Михайлов М. М., Федосов Д. С., Лапин А. Н., Юрьев С. А., Горончко В. А.</i> | |
|  | РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НИТЕВИДНЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ GaPnAsGaP ТИПА ЯДРО-ОБОЛОЧКА НА ПОДЛОЖКЕ $\text{Si}(111)$ | 73-80 |
| | <i>Маленин А. П., Кавеев А. К., Федоров В. В., Минин Д. В., Мухин И. С.</i> | |

	ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ГЕЛИЯ И ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И МИКРОТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА V-10Ti-6Cr-0.05Zr-0.1Si	81-88
	<i>Боровицкая И. В., Пименов В. Н., Коршунов С. Н., Мансурова А. Н., Бондаренко Г. Г., Гайдар А. И., Матвеев Е. В., Латышев С. В., Казилин Е. Е.</i>	
	О ВЛИЯНИИ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧНОСТЬ И МИКРОТВЕРДОСТЬ СПЛАВА ZN-AL-CU-MG	89-93
	<i>Велиханов А. Р.</i>	
	ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ФАЗОВОГО АНАЛИЗА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ФОРМИРУЕМЫХ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО АДДИТИВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ	94-100
	<i>Голышев А. А., Герцель И. С., Завьялов А. П., Мамутов Р. З., Маликов А. Г.</i>	
	КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ТЕМПЕРАТУРНУЮ САМОКОМПЕНСАЦИЮ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ЧИП-РЕЗИСТОРОВ	101-107
	<i>Печерская Е. А., Гурин С. А., Коновалов С. В., Шепелева А. Э., Новичков М. Д.</i>	
	ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ И УСТАЛОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6, УПРОЧНЕННОГО ЛАЗЕРНОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКОЙ	108-116
	<i>Ляховецкий М. А., Королев Д. Д., Кожевников Г. Д., Азуреев Л. Е., Кравченко Г. Н., Забенько Е. В.</i>	
	ЗАПОЛНЕНИЕ СОСТОЯНИЙ В РЕЖИМЕ ПЛОСКОСТНОГО КАНАЛИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЗОНАНСНОГО ЗАХВАТА РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В СОСТОЯНИЕ АКСИАЛЬНОГО КАНАЛИРОВАНИЯ В МОНОКРИСТАЛЛЕ	117-121
	<i>Калашников Н. П., Ольчак А. С.</i>	
	СИНТЕЗ ТОНКИХ ПЛЕНОК NiO [111] НА ПОДЛОЖКАХ C-AL₂O₃ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ОСАЖДЕНИЯ	122-126
	<i>Гусев Д. С., Паршина Л. С., Потехина Н. В., Елисеев Н. Н., Николаева И. Н., Воронин Р. И., Храмова О. Д., Новодворский О. А., Шкуринов А. П.</i>	